

2019年3月29日

資金調達実施のお知らせ

～FLOSFIA、「コランダム構造酸化ガリウム (α -Ga₂O₃)」の事業化を加速～

注目のパワー半導体『コランダム構造酸化ガリウム (以下「 α -Ga₂O₃」)』の開発販売を手掛ける株式会社 FLOSFIA (本社：京都府京都市、代表取締役社長：人羅俊実、以下「FLOSFIA」) は、この度、シリーズ D ラウンドの資金調達を開始、その第一弾として、**JSR 株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：小柴満信)、合同会社 MHI イノベーション推進研究所 (本社：東京都千代田区、代表：名山理介) を割当先とする第三者割当増資 (合計約 4 億 5 千万円) を実施**いたしました。これにより、FLOSFIA の資金調達額はこれまでの資金調達を含め累計で約 27.1 億円となりました。

α -Ga₂O₃ は京都大学藤田静雄教授が世界で初めて単結晶の合成に成功した画期的半導体で、シリコン比 6,000 倍を超える材料物性 (バリガ性能指数での比較) を有します。FLOSFIA は京都大学発のベンチャー企業として、世界に先駆けて α -Ga₂O₃ パワー半導体の事業化に取り組んでおり、「GaO®」シリーズとしてサンプル出荷を開始しています。

これまでに、既に SBD (ショットキーバリアダイオード) の実証試作を通じて、世界トップデータとなる特性オン抵抗値の実現や実装デバイスでの高速動作の確認、コンバーターでの変換効率アップ等に成功してまいりました。さらに 2018 年 7 月には、材料特性上不可能と考えられてきた FET (トランジスタ) のノーマリーオフ動作実証にも成功するなど、 α -Ga₂O₃ の高いポテンシャルを証明してまいりました。

FLOSFIA では、本ラウンドで戦略的パートナーシップ構築と長期成長に向けた基盤づくりを行うとともに、2019 年中の SBD 量産体制構築、その後の FET のサンプル出荷・量産化を加速させ、より幅広い産業領域への展開を進めてまいります。さらに、「GaO®」デバイスの早い応答性、小さなオン抵抗値等により、**ロボットの駆動回路や電気自動車のインバーター回路など、機器の電動化、小型化、損失低減等**を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【FLOSFIA について】

会社名：株式会社 FLOSFIA (フロスフィア)

<http://flosfia.com>

所在地：京都市西京区御陵大原 1 番 29 号

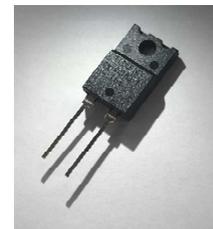
代表者：代表取締役社長 人羅俊実

資本金等：27 億 1 千万円 (資本準備金含む)

事業内容：酸化ガリウム系パワーデバイスの研究・製造・販売 (パワーデバイス事業)

各種金属酸化膜等の受託成膜、コーティング (成膜ソリューション事業)

その他：FLOSFIA は経済産業省が推進する「J-Startup」の認定企業です。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 FLOSFIA コーポレートサポート部 (担当：間嶋)

TEL：075-963-5202 / Mail：info@flosfia.com

以上